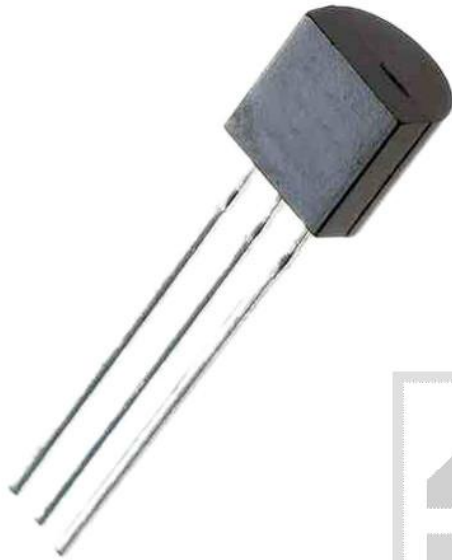




MPSA92;TO92;LGE;tranzystor; PNP;500mA;300V;625mW;50MHz;Pbf



Dane techniczne:

Nazwa: MPSA92

Typ tranzystora: bipolarny

Kierunek przewodnictwa: PNP

Prąd kolektora: 500mA

Napięcie kolektor-emiter: 300V

Moc: 625mW

Częstotliwość: 50MHz

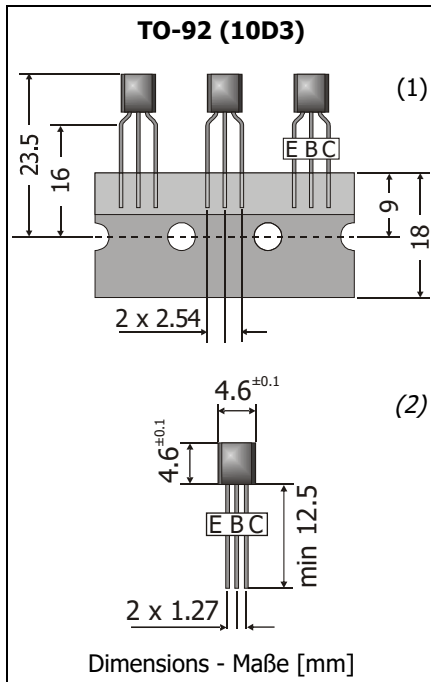
Montaż: przewlekany(THT)

Obudowa: TO92

Producent: LGE

MPSA92 High Voltage PNP Transistors Hochspannungs-PNP-Transistoren	I_C = - 500 mA h_{FE1} > 40 T_{jmax} = 150°C	V_{CEO} = - 300 V P_{tot} = 625 mW
---	--	---

Version 2018-01-19



Typical Applications

Signal processing,
Switching, Amplification
Commercial grade ¹⁾

Features

High collector voltage
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals ¹⁾



Mechanical Data ¹⁾

(1) Taped in ammo pack (Raster 2.54)	4000
(2) On request: in bulk (Raster 1.27, suffix "BK")	5000
Weight approx.	0.18 g
Case material	UL 94V-0
Solder & assembly conditions	260°C/10s MSL N/A

Typische Anwendungen

Signalverarbeitung,
Schalten, Verstärken
Standardausführung ¹⁾

Besonderheiten

Hohe Kollektorspannung
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

(1) Gegurtet in Ammo-Pack (Raster 2.54)	4000
(2) Auf Anfrage: Schüttgut (Raster 1.27, Suffix "BK")	5000
Gewicht ca.	0.18 g
Gehäusematerial	UL 94V-0
Löt- und Einbaubedingungen	260°C/10s MSL N/A

Recommended complementary NPN transistors Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren	MPSA42
--	--------

Maximum ratings ²⁾

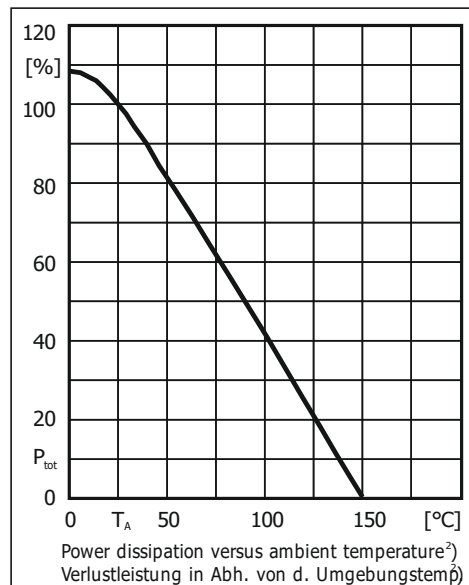
Grenzwerte ²⁾

			MPSA92
Collector-Emitter-voltage Kollektor-Emitter-Spannung	B open	- V _{CEO}	300 V
Collector-Base-voltage Kollektor-Basis-Spannung	E open	- V _{CBO}	300 V
Emitter-Base-voltage Emitter-Basis-Spannung	C open	- V _{EBO}	5 V
Power dissipation Verlustleistung		P _{tot}	625 mW ³⁾
Collector current Kollektorstrom	DC	- I _C	500 mA
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _j T _s	-55...+150°C -55...+150°C

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
2 T_A = 25°C, unless otherwise specified – T_A = 25°C, wenn nicht anders angegeben
3 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from the case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics
Kennwerte

		$T_j = 25^\circ\text{C}$	Min.	Typ.	Max.
Collector-Base cutoff current – Kollektorreststrom $I_E = 0$ $-V_{CB} = 200\text{ V}$		$-I_{CBO}$	–	–	250 nA
Emitter-Base cutoff current – Emitterreststrom $I_B = 0$ $-V_{EB} = 3\text{ V}$		$-I_{EBO}$	–	–	100 nA
Collector saturation voltage – Kollektor-Sättigungsspannung ¹⁾ $-I_C = 20\text{ mA}$ $-I_B = 2\text{ mA}$		$-V_{CEsat}$	–	–	500 mV
Base saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung ⁴⁾ $-I_C = 20\text{ mA}$ $-I_B = 2\text{ mA}$		$-V_{BEsat}$	–	–	0.9 V
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ¹⁾ $-V_{CE} = 10\text{ V}$ $-I_C = 1\text{ mA}$ $-I_C = 10\text{ mA}$ $-I_C = 30\text{ mA}$		h_{FE}	25 40 25	– – –	– – –
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz $-V_{CE} = 20\text{ V}$, $-I_C = 10\text{ mA}$, $f = 100\text{ MHz}$		f_T	–	70 MHz	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität $-V_{CB} = 20\text{ V}$, $I_E = i_e = 0$, $f = 1\text{ MHz}$		C_{CBO}	–	–	7 pF
Thermal resistance junction – ambient Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung		R_{thA}	< 200 K/W ²⁾		



Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Tested with pulses $t_p = 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\ \mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$
 2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from the case
 Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden